

ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I_{RM}	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_{RM} = V_{RRM}$	5	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V_{FM}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{FM} = 75\text{A}$	1.25	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$	接合部-ケース間(トータル) Junction to Case, Total	0.09	$^{\circ}\text{C/W}$

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 Arm.)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V_{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V_{DSM}	1700	V

*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I_{TSM}	50Hz 正弦半波, 1サージ, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1200	A
電流二乗時間積 I Squared t	I^2t	2~10ms	7200	A^2s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D = 2/3 V_{DRM}$, $I_{TM} = 2 \cdot I_o$, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$ $I_G = 200\text{mA}$, $di_G/dt = 0.2\text{A}/\mu\text{s}$	100	$\text{A}/\mu\text{s}$
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V

■電気的特性 Electrical Characteristics

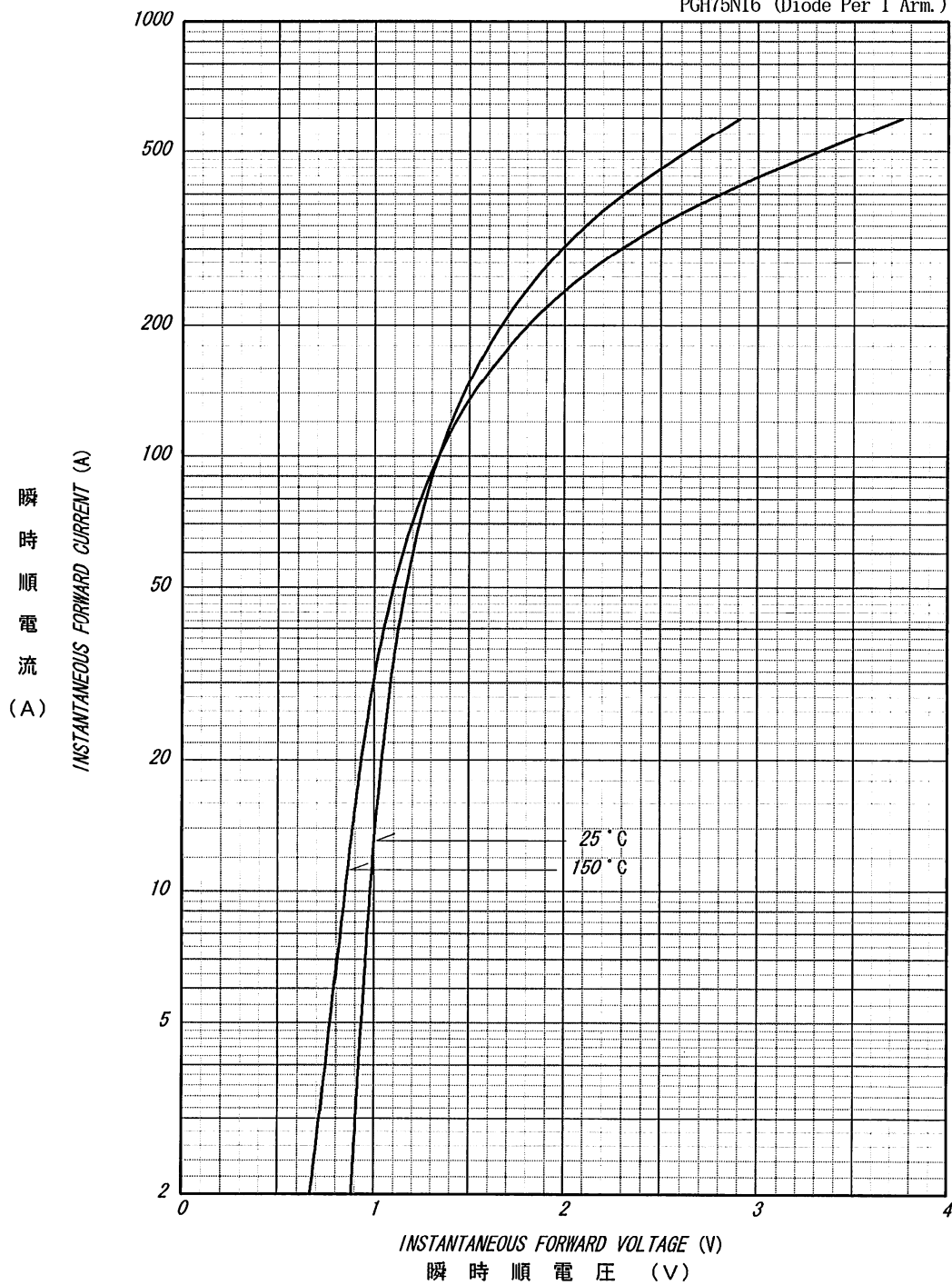
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I_{DM}	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = V_{DRM}$			15	mA
ピークオン電圧 Peak Off-State Voltage	V_{TM}	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 75\text{A}$			1.20	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$			200	mA
					100	
					50	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$V_D = 6\text{V}$, $I_T = 1\text{A}$			4.0	V
					2.5	
					2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V_{GD}	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$	500			$\text{V}/\mu\text{s}$
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t_q	$T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = I_o$, $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $dv/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$, $-di/dt = 20\text{A}/\mu\text{s}$		150		μs

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}	T _j =25℃, V _D =2/3 V _{DRM} , I _T =3・I _O I _G =200mA, di _G /dt=0.2A/ μ s		6		μ s
遅れ時間 Delay Time	t _d			2		μ s
立ち上がり時間 Rise Time	t _r			4		μ s
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25℃		100		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25℃		80		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(jc)}	接合部－ケース間 Junction to Case			0.3	℃/W

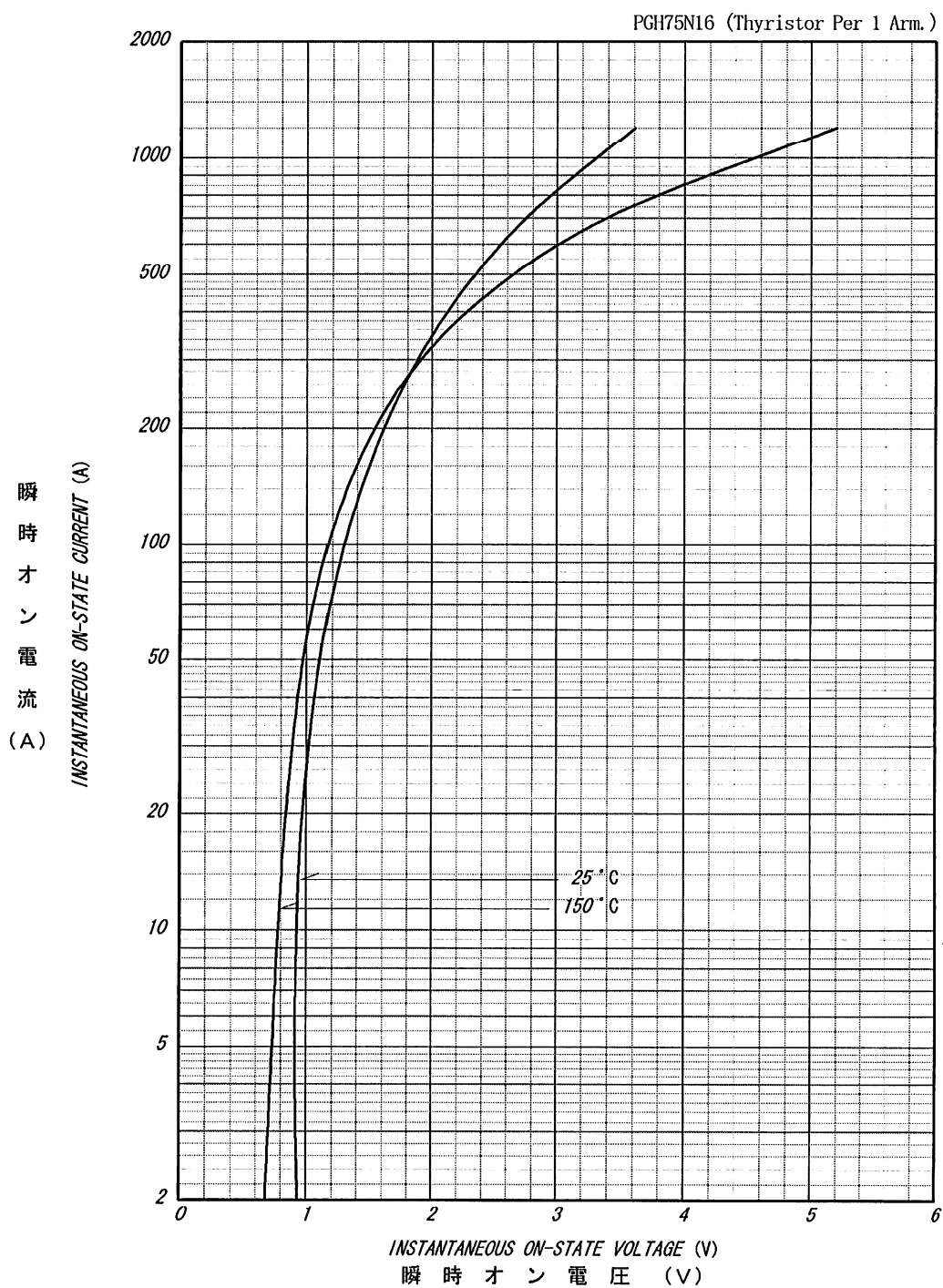
質 量 --- 約 225 g
Approximate Weight

順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

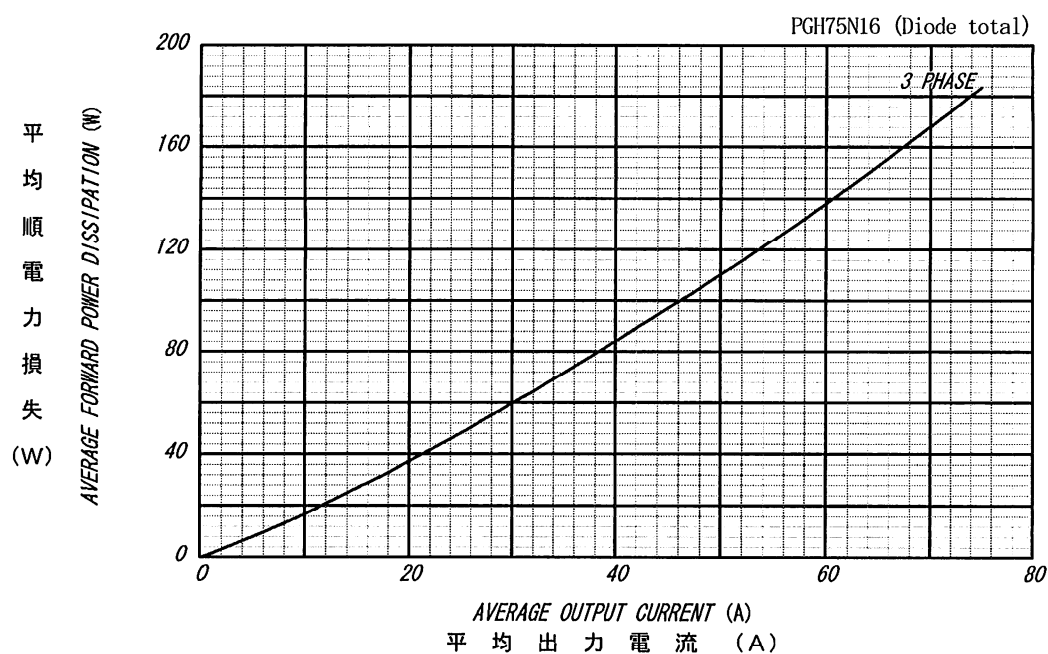
PGH75N16 (Diode Per 1 Arm.)



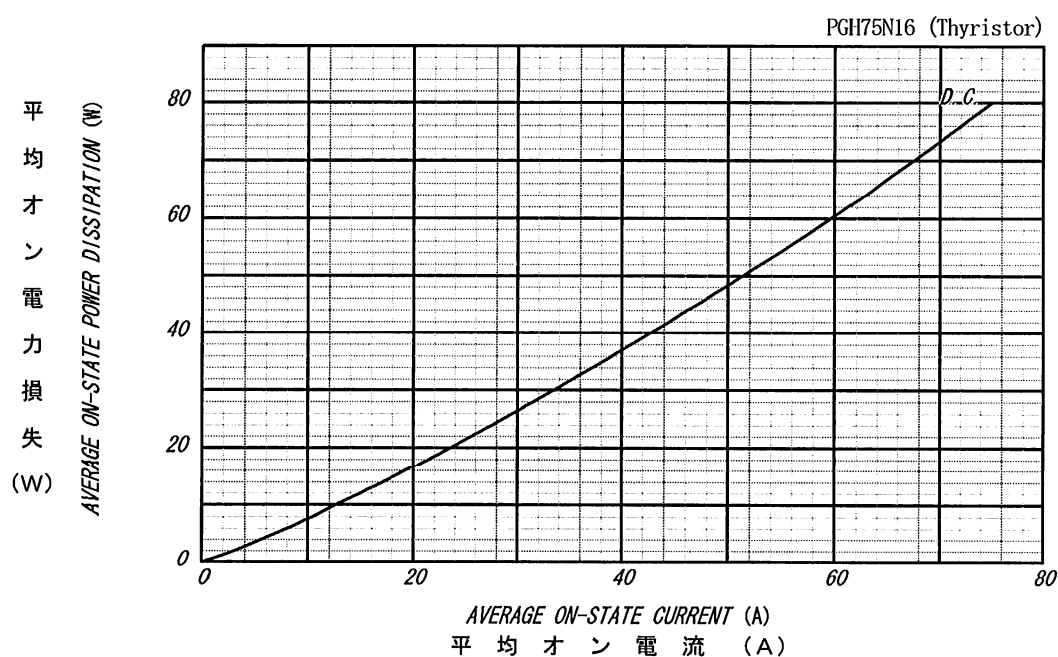
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

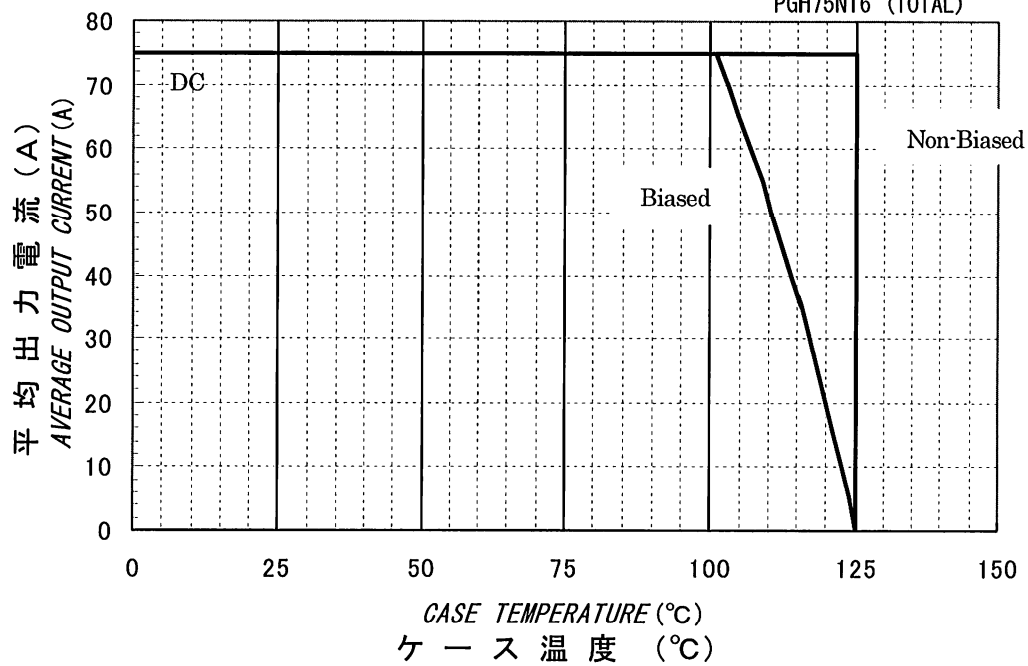


平均出力電流－ケース温度定格

AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load

PGH75N16 (TOTAL)

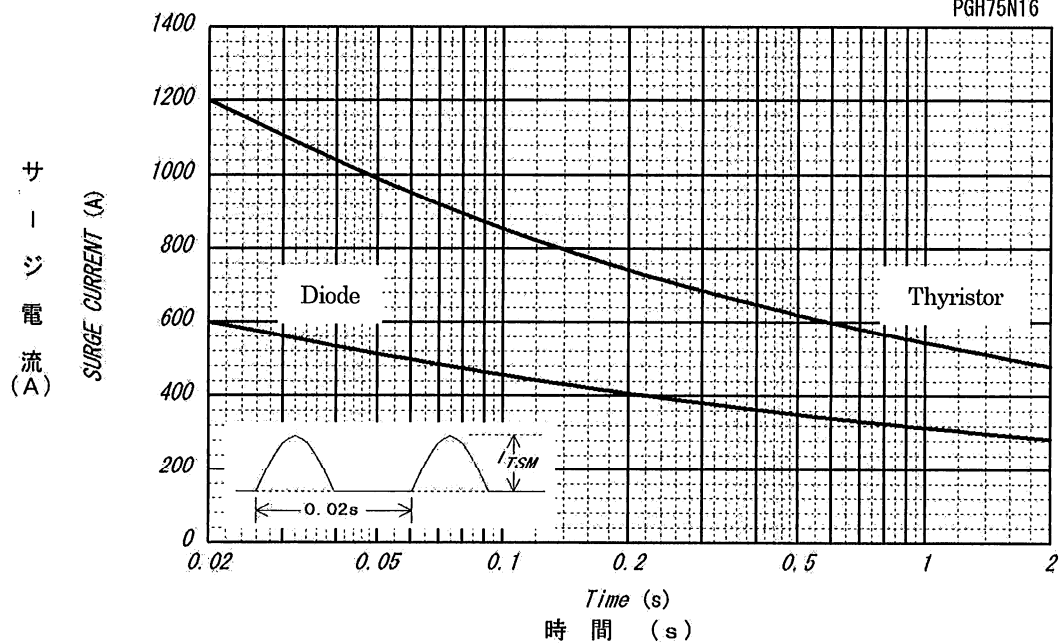


サージ電流定格

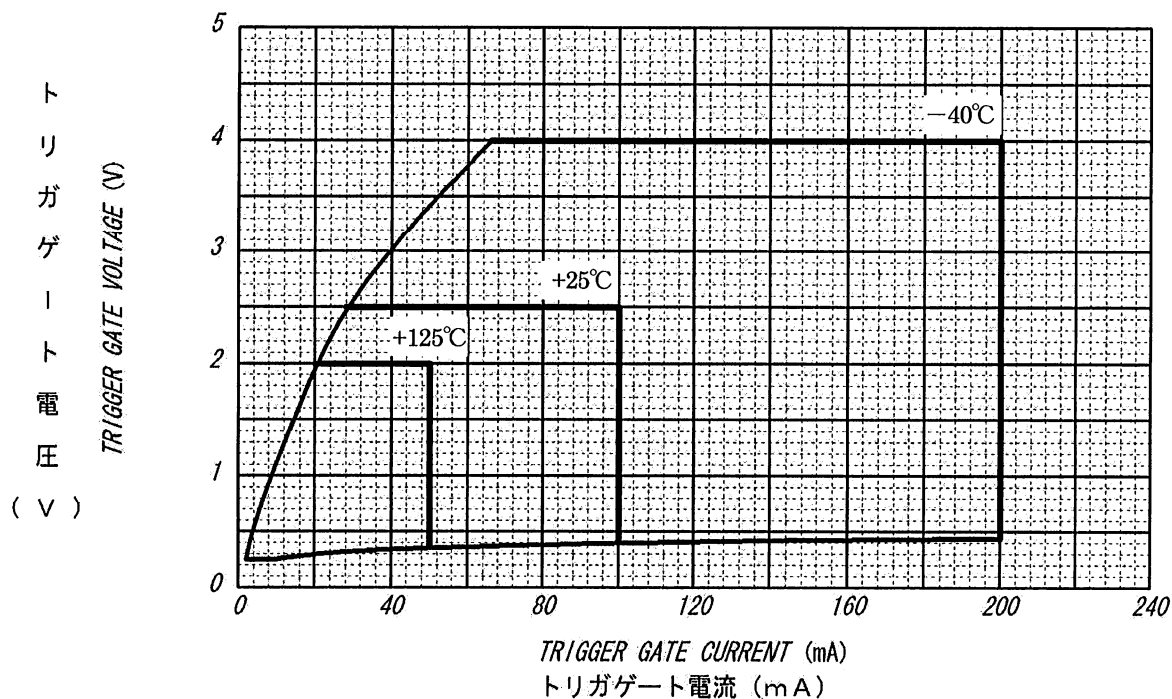
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

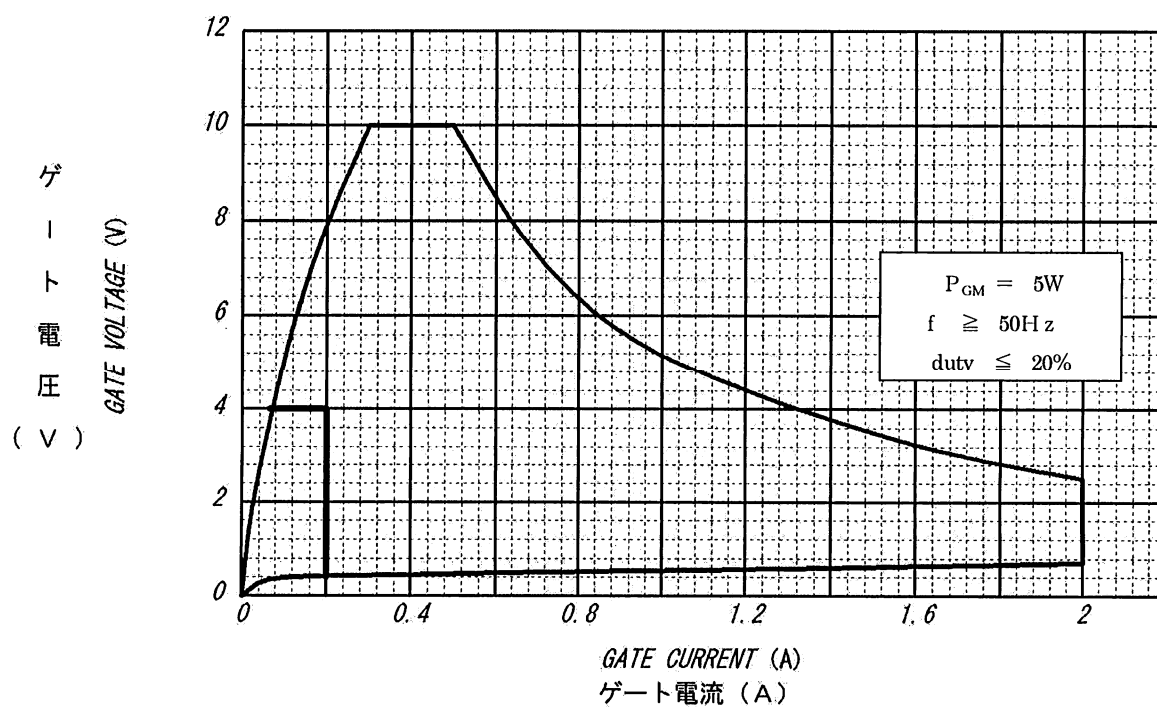
PGH75N16



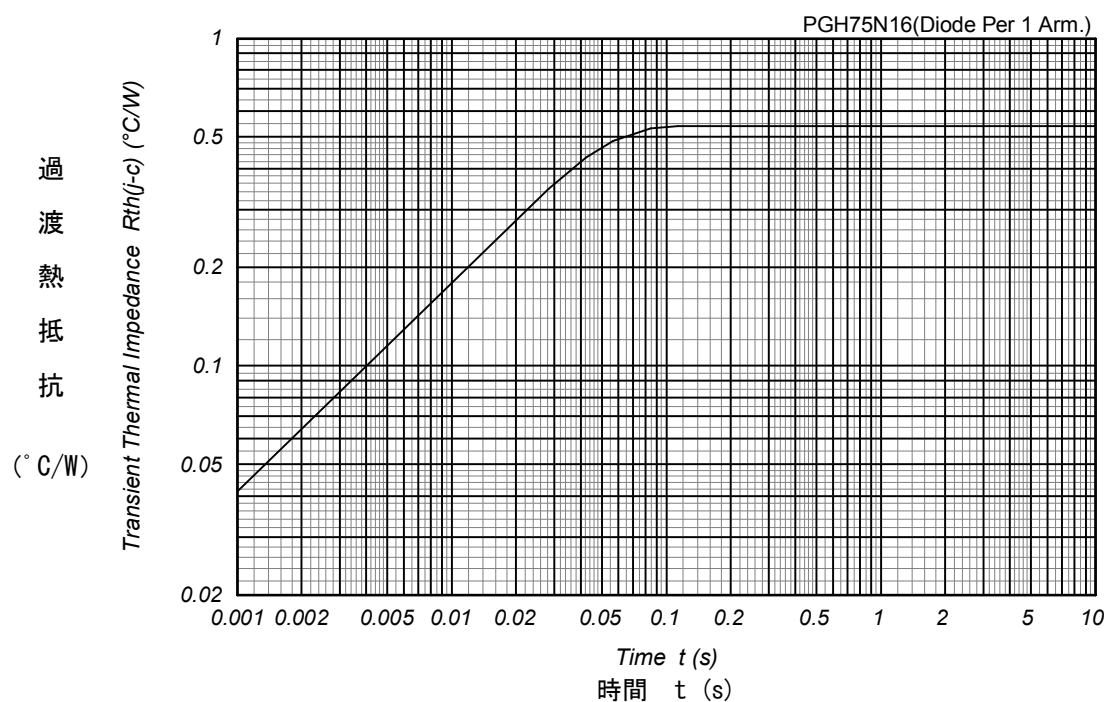
ゲート特性 GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格 GATE RATINGS



過 渡 熱 抵 抗 特 性
Transient Thermal Impedance



過 渡 熱 抵 抗 特 性
Transient Thermal Impedance

